

Title (en)

LOGIC CIRCUITS FOR AN AMORPHOUS SILICONE SELF-SCANNED MATRIX SYSTEM.

Title (de)

LOGISCHE SCHALTUNGEN WIE FÜR EIN SELBSTABGETASTETES MATRIXSYSTEM AUS AMORPHEM SILIZIUM.

Title (fr)

CIRCUITS LOGIQUES POUR UN SYSTEME MATRICIEL AUTO-BALAYE AU SILICIUM AMORPHE.

Publication

EP 0513328 A1 19921119 (FR)

Application

EP 92901620 A 19911203

Priority

US 62068290 A 19901203

Abstract (en)

[origin: WO9209986A1] A logic circuit is comprised of charge and dropper transistors as well as a capacitor, the main conductor links of said transistors and capacitor being connected in series between a first supply bus and a time variable potential source. The charge transistor is connected to the capacitor, and the capacitor is connected to the time variable potential source. A first and a second logic signal are applied to the respective control electrodes of the first and second transistors. The time variable potential is provided to limit the charge passing to the charge transistor, thus allowing to use a relatively small dropper transistor. The time variable potential has an amplitude sufficiently large to have a tendency for actuating the charge transistor, if the latter is non-conductive. A selective conducting element (diode) is connected between a locking potential point and the connection between the charge transistor and the capacitor.

Abstract (fr)

Un circuit logique comprend des transistors de charge et chuteurs ainsi qu'un condensateur, les liaisons conductrices principales de ces transistors et ce condensateur étant reliées en série entre un premier bus d'alimentation et une source de potentiel variant dans le temps. Le transistor de charge est connecté au condensateur, et le condensateur au potentiel variant dans le temps. Un premier et un second signal logique sont appliqués aux électrodes de contrôle respectives des premier et second transistors. Le potentiel variable dans le temps est prévu pour limiter la charge passant par le transistor de charge, ce qui permet d'utiliser un transistor chuteur relativement petit. Le potentiel variant dans le temps a une amplitude suffisamment large pour avoir tendance à activer le transistor de charge, si ce transistor est non-conducteur. Un élément de conduction sélective (diode) est relié entre un point de potentiel de verrouillage, et la connexion entre le transistor de charge et le condensateur.

IPC 1-7

G09G 3/36

IPC 8 full level

G02F 1/133 (2006.01); **G02F 1/136** (2006.01); **G02F 1/1368** (2006.01); **G09G 3/20** (2006.01); **G09G 3/36** (2006.01)

CPC (source: EP US)

G09G 3/2011 (2013.01 - EP US); **G09G 3/3688** (2013.01 - EP US); **G09G 2310/027** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

See references of WO 9209986A1

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB NL

DOCDB simple family (publication)

WO 9209986 A1 19920611; EP 0513328 A1 19921119; JP H05504212 A 19930701; US 5148058 A 19920915

DOCDB simple family (application)

FR 9100960 W 19911203; EP 92901620 A 19911203; JP 50210891 A 19911203; US 62068290 A 19901203